Procedimiento de fabricación de dispositivos optoelectrónicos de banda intermedia basados en tecnología de lámina delgada

Información de contacto

Dirección: Principales:

- ANTONIO MARTI VEGA

antonio.marti@upm.es

- DAVID FUERTES MARRON

david.fuertes@upm.es

- ANTONIO LUQUE LOPEZ

a.luque@upm.es

Tipo de oferta tecnológica

Patentes

¿Dónde?

Instituto de Energía Solar (IES) Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares

Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=161&id_archivo=127&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

Descripción de la patente

Procedimiento de fabricación de dispositivos optoelectrónicos de banda intermedia basados en tecnología de lámina delgada caracterizado porque comprende, al menos, las siguientes etapas:

- una primera etapa, donde sobre un substrato (1) se deposita una capa metálica (2) que actuará como electrodo;
- una segunda etapa, donde sobre la capa metálica (2) se deposita un elemento semiconductor de tipo p (3); y
- una tercera etapa, de procesado del material de banda intermedia;

donde dicho material de banda intermedia consiste en un estructuras nanoscópicas (4) de material multinario de tipo (Cu, Ag)(Al, Ga, In)(S, Se, Te)₂ embebido en una matriz (5) de composición similar, salvo por la ausencia de, al menos, un catión presente en la estructura nanoscópica.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P200801711

Número de publicación

ES2311431

Fecha de presentación

06/06/2008

Fecha de concesión

07/07/2009